



第6回

筑波大学パワーエレクトロニクス未来技術研究会

University of Tsukuba Forum on Power Electronics Tomorrow (UTOP)

「SiC トレンチ MOSFET デバイス並びにその適用技術」

日時： 2017年3月3日(金) 13時20分～17時40分

場所： 筑波大学東京キャンパス文京校舎1階134講義室

東京都文京区大塚3-29-1 (地下鉄丸ノ内線茗荷谷駅より徒歩2分)

参加費： 3,000円 (資料代を含む、学生は無料)

意見交換会： 林野会館にて

主催： 筑波大学数理物質系

共催： NPO 未来アジア技術フォーラム (TeFFA)

後援： パワーエレクトロニクス学会

協賛： Tsukuba Power Electronics Constellations (TPEC)

プログラム

座長： 筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 助教 岡本 大

13:20 筑波大学パワーエレクトロニクス研究室の近況ご紹介

筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 教授 岩室 憲幸

13:30 2016年度筑波大学パワエレ研発表-1 @ EPE 2016 ECCE, Karlsruhe, Germany (Sep 2016)

「A dead-time minimized inverter by using complementary topology and its experimental evaluation of harmonics reduction」

筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 修士2年 奥田 一真

13:55 2016年度筑波大学パワエレ研発表-2 @ IEEE IEDM 2016, San Francisco, USA (Dec 2016)

「Experimental demonstration of -730V vertical SiC p-MOSFET with high short circuit withstand capability for complementary inverter applications」

筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 博士2年 安 俊傑

14:20 「SiC V 溝型 MOSFET 及びその周辺技術に関する開発」

住友電気(株) パワーデバイス開発部 技術部 部長 御神村 泰樹

15:10～15:25 休憩

座長： 筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 准教授 矢野 裕司

15:25 「トレンチ型 SiC デバイスの特性とその応用」

ローム(株) 研究開発部 部長 中村 孝

16:15 「SiC モジュールと SiC 適用変換器の開発」

(株)東芝 ESS 社 電力・社会システム技術開発センター 電機電池応用・パワーシステム開発部
パワーエレクトロニクス技術担当 主務 葛巻 淳彦

司会： 筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 教授 只野 博

17:10 パネルディスカッション「より使いやすい SiC パワーデバイスを目指して」

17:40 閉会

18:00～19:30 意見交換会 (会費 3,000円)

参加申し込み先：teffareg@ybb.ne.jp (2/24(金) 締切り)

(氏名、所属、e-mailアドレス、意見交換会への参加/不参加をご連絡ください。)